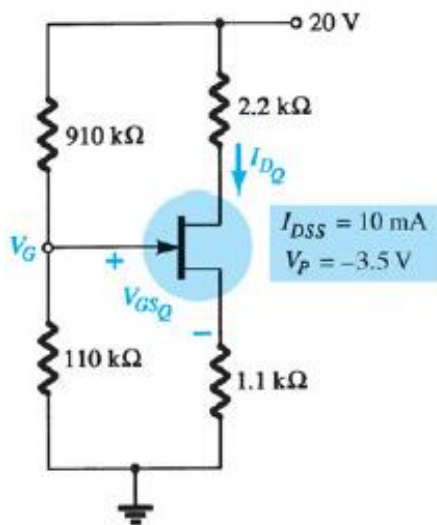
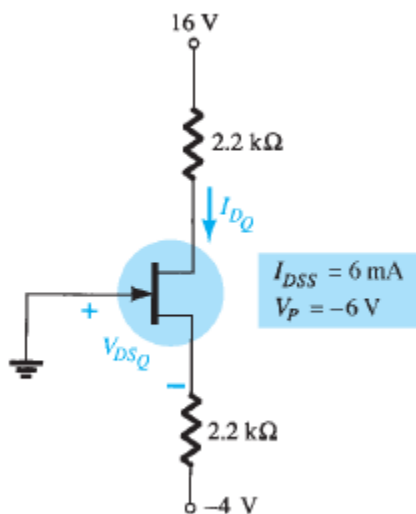


Πρόβλημα 5.γ.1



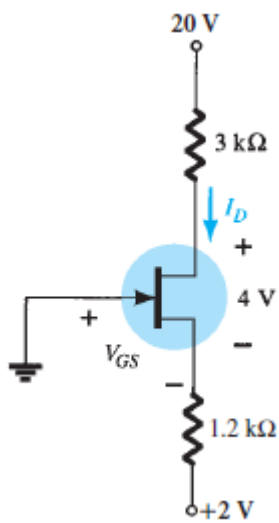
α) Βρείτε το ρεύμα I_D , την τάση V_{DS} και την τάση V_{GS} στο σημείο λειτουργίας. β) Υπολογίστε το δυναμικό στον απαγωγό V_D , της πηγής V_S και της πύλης V_G . γ) Ποιο θα είναι το σημείο λειτουργίας εάν η αντίσταση στην πηγή γίνει $R_S=0,55\text{k}\Omega$; Ποια είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει η αντίσταση R_S ;

Πρόβλημα 4.γ.2



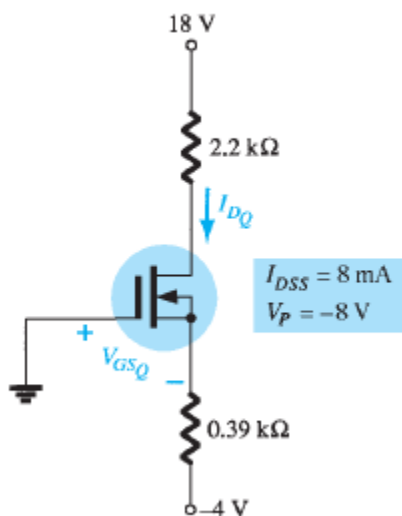
α) Βρείτε το ρεύμα I_D , την τάση V_{DS} και την τάση V_{GS} στο σημείο λειτουργίας. β) Υπολογίστε το δυναμικό του απαγωγό V_D , της πηγής V_S και της πύλης V_G .

Πρόβλημα 4.γ.3



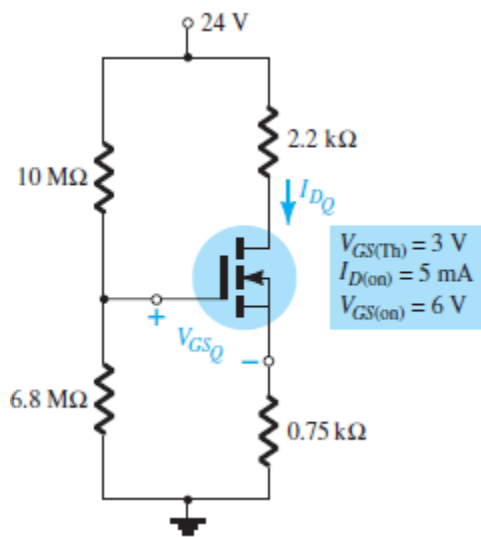
Βρείτε το ρεύμα I_D , το δυναμικό στον απαγωγό V_D , στην πηγή V_S , την πύλη V_G και την τάση V_{GS} στο σημείο λειτουργίας.

Πρόβλημα 4.γ.4



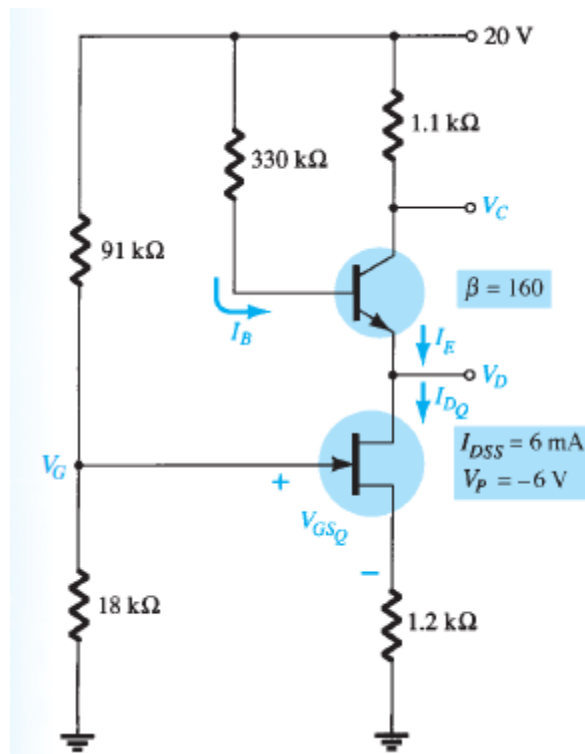
α) Βρείτε το ρεύμα I_D , την τάση V_{DS} και την τάση V_{GS} στο σημείο λειτουργίας. β) Υπολογίστε το δυναμικό του απαγωγό V_D , της πηγής V_S και της πύλης V_G .

Πρόβλημα 4.γ.5



Υπολογίστε το ρεύμα I_D στο σημείο λειτουργίας και την τάση πύλης-πηγής.

Πρόβλημα 4.γ.6



Υπολογίστε τα: V_G , V_{GSQ} , I_{DQ} , I_B , I_E και V_C .

depletion MOSFET: στα ελληνικά αποδίδεται σαν: εκκένωσης, διακένωσης, κένωσης, αραιώσης, απογύμνωσης.

enhancement MOSFET: στα ελληνικά αποδίδεται σαν: προσαύξησης, πύκνωσης, επαγωγής, εμπλουτισμού.